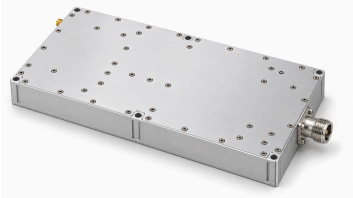
20–520 MHz LDMOS RFパワーアンプ、標準飽和出力350 W



LDMOSアンプは20–520 MHzで標準飽和出力350 W、1 dB圧縮点の標準出力150 Wを備えます。標準利得56 dB、350 W時の標準電流29 A、標準電源48 VDCです。

最大寸法245 × 150 × 30 mm、最大質量3.5 kg、入力SMA、出力N-Kです。動作温度は0–50 °Cで、原件は3.3 V TTLイネーブルと内部プルダウン、350 Wでの負荷VSWR 3:1を規定します。 記載された動作温度は環境設計目標であり、資料はこの範囲の認定を示していません。

電気仕様 +48.0VDC; 25°C; 50Ω

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
動作周波数	BW	20	-	520	MHz
1 dB圧縮点出力電力	P-1dB	-	150	-	W
RF出力電力 @ PSAT	PSAT	-	350	-	W
電力利得 @ PSAT	Gp	-	56	-	dB
電力利得平坦度 @ PSAT	ΔGp	-	±2	-	dB
入力リターンロス	S11	-	-	-15	dB
350 W 時の高調波	H	-	-12	-	dBc
スプリアス信号 @ PSAT	Spur	-	-60	-	dBc
入出力インピーダンス	Impedance	-	50	-	Ω
動作電圧	VDC	-	48	-	VDC
電力付加効率 @ 350W	Eff	-	25	-	%
DC電流 @ 350W	IDD	-	29	-	A

絶対最大定格

項目	定格
損傷を生じない RF 入力電力	+5 dBm 最大
Pout = 350 W 時の負荷 VSWR	3:1; 全負荷位相・振幅、連続
熱過負荷	85 °C → 停止 (最大)

環境仕様

記載の環境条件は設計目標値です。ご使用の案件に適用される条件を確認してください。

項目	最小値	代表値	最大値	単位
動作温度	0	-	50	°C
保存温度 [1]	-45	-	80	°C
相対湿度（結露なし）	-	-	95	%

[1] 保存温度

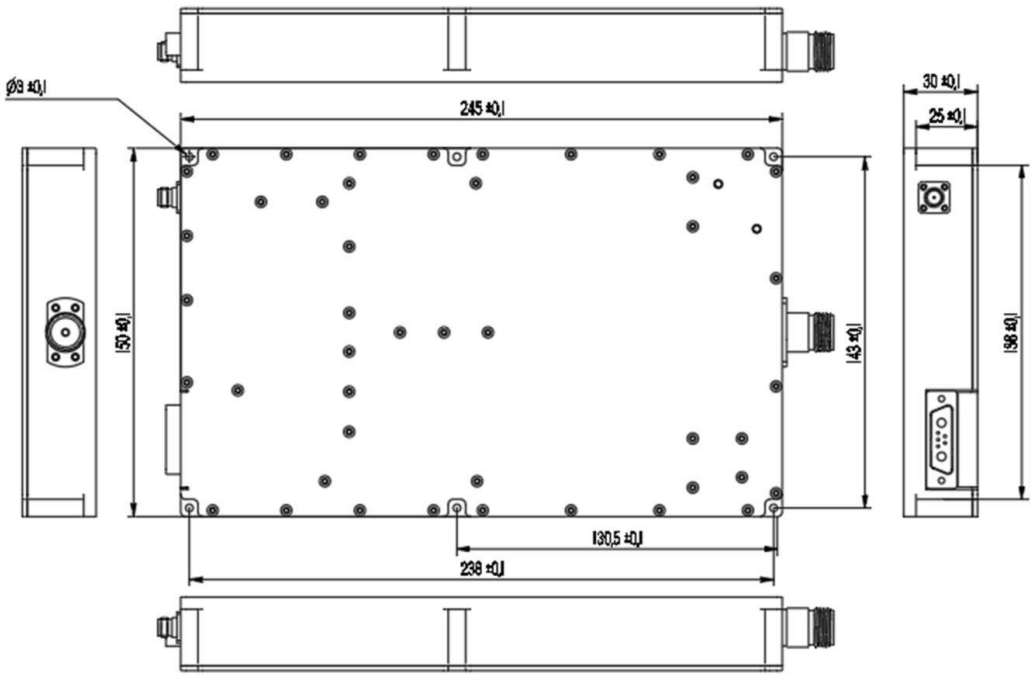
DC および制御インターフェース

ピン番号	説明	仕様
1	1 — イネーブル	TTLハイレベル（3.3 V）、内部プルダウン
2	2 — グラウンド	グラウンド
3	3 — 未接続	未接続
4	4 — 未接続	未接続
5	5 — 未接続	未接続

機械仕様

原資料ではA1の名称がGND、機能が+48 Vで、A2の名称がVDD、機能が接地です。この電源ピン割当は掲載していません。電圧を印加する前に電源と接地の配線を確認し、ピンが入れ替わっていると推定しないでください。

項目	値	単位
外形寸法	245 × 150 × 30 mm (最大)	mm
質量	3.5 kg (最大)	kg
RF 入力コネクタ	SMA, メス	-
RF 出力コネクタ	N-K	-
DC／制御インターフェース	ハイブリッド, D-Sub 7, オス	-



現在の発行記録 · 1.3 · 2026-11-11. 仕様表の内容を更新しました。 置き換え対象の改訂版 1.2.

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。